(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[6]
H01L 21/318

(11) 공개번호 특1997-0077347
(43) 공개일자 1997년12월12일

(21) 출원번호 특1996-0014101
(22) 출원일자 1996년05월01일

(71) 출원인 재단법인 한국화학연구소 강박광
대전광역시 유성구 장동 100 (우 : 305-343)
(72) 발명자 김윤수
대전광역시 유성구 도룡동 383-11
김창균
대전광역시 유성구 도룡동 431 공동관리아파트 8동 502호
박준택
대전광역시 유성구 어은동 99 한빛아파트 107동 1804호
김윤수
대전광역시 유성구 어은동 101-13
(74) 대리인 장성구, 조현실

심사청구 : 있음

(54) 규소 기질 위에 질화갈륨 막을 형성하는 방법

요약

본 발명에서는 규소(111) 기질 위에 아연의 화합물을 화학 증착시켜 산화아연 완충층을 형성하고, 상기 완충층 위에 유기갈륨 화합물을 화학 증착시켜 질화갈륨 막을 형성하는 것을 포함하는 규소 기질에 질화갈륨 막을 형성하는 방법이 개시되어 있다.

명세서

[발명의 명칭]

규소 기질 위에 질화갈륨 막을 형성하는 방법

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

규소(111) 기질 위에 아연 화합물을 화학 증착시켜 산화아연 완충층을 형성하고, 상기 완충층 위에 유기갈륨 화합물을 화학 증착시켜 질화갈륨 막을 형성하는 것을 포함하는 규소 기질 위에 질화갈륨 막을 형성하는 방법.

청구항 2

제1항에 있어서, 아연 화합물이 비스(2,2,6,6-테트라메틸-3,5-헵탄디오나토)아연, 아세틸아세톤산아연 또는 아세트산아연인 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 3

제1항에 있어서, 유기갈륨 화합물이 비스(디에틸-μ-아미도-갈륨) 또는 비스[디메틸(1,2-디메틸히드라지도)갈륨]인 것을 특징으로 하는 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.